

АП331А-2, АП331А-5



ПОЛЕВЫЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ СВЧ
LOW POWER MICROWAVE FETs

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Арсенидгаллиевые полевые с барьером Шоттки и каналом n-типа проводимости транзисторы АП331А-2, АП331А-5 с расширенным динамическим диапазоном предназначены для применения в широкополосных СВЧ усилителях с повышенными требованиями к выходной мощности для внутреннего монтажа в гибридных микросхемах, микросборках, блоках и аппаратуре, обеспечивающих герметизацию и защиту транзисторов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, инея и росы, агрессивных газов и смесей, пониженного и повышенного давления, солнечной радиации.

Оформление - бескорпусное.

Транзисторы модификации 2 - с гибкими выводами на кристаллодержателе; модификации 5 - с контактными площадками без кристаллодержателя, без выводов.

Диапазон допустимых рабочих температур от -60 до +85°С.

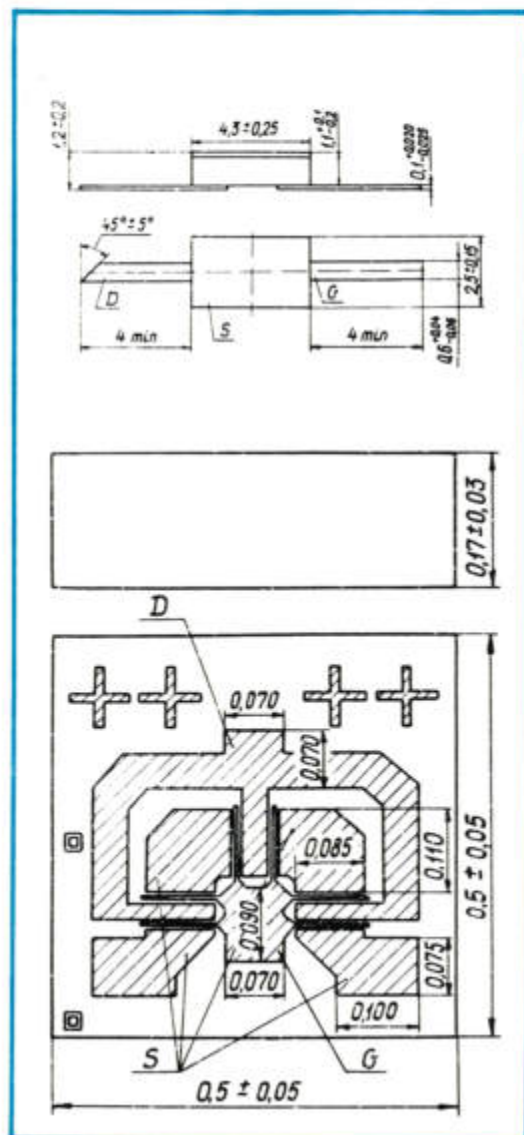
GENERAL DESCRIPTION

The АП331А-2, АП331А-5 transistors are GaAs n-channel metal-Schottky gate field-effect transistors with enhanced dynamic range designed for use in wide-band microwave amplifiers with more demanding requirement to output power mounted within hybrid microcircuits, microassemblies, assemblies and equipment that provide hermetic sealing and protection of the transistors against the effects of moisture, salt spray, mouldy fungi, hoar-frost and dew, aggressive gases and mixtures, low and high pressures and solar radiation.

These are unpackaged transistors.

Modification 2 transistors are provided with flexible leads on the chipcarriers. Modification 5 transistors have pads, no chipcarriers or leads.

Allowable operating temperatures: -60 to +85°С.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

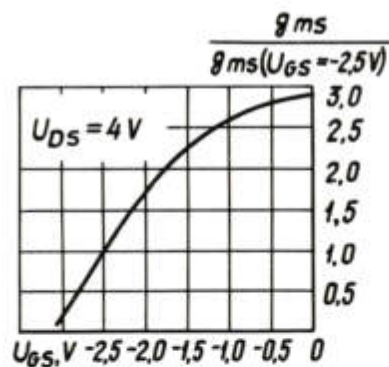
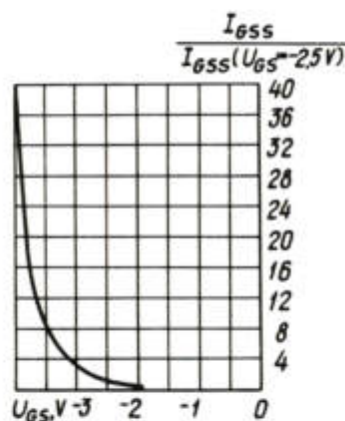
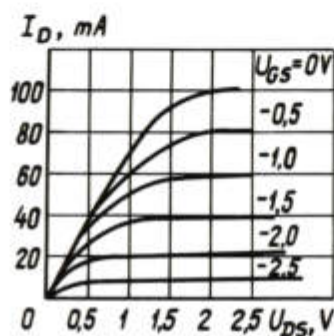
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

$U_{DS \max}$	5 V
$U_{GS \max}$	-4 V
$U_{GD \max}$	-8 V
$P_{DS \max}$	200 mW

АПЗ31А-2, АПЗ31А-5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions		
		$U_{DS}; U_{GS}^*$ V	I_D , mA	f , GHz
I_{GSS} , μA	< 1	$-2,5^*$		
g_{ms} , mA/V	> 15	4	40	$5 \cdot 10^{-6}$
G_{pmax} , dB	> 8	4	40	10
P_{out} , mW	> 30	4	40	10
F_{min} , dB	$< 4,5$	4	40	10



АП331А-2, АП331А-5

